









	<h2 style="color: red;">FQD12N20LTF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD12N20LTF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD12N20LTF.pdf</a> <a href="#">2.FQD12N20LTF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD12N20LTF ist neu im Original, Suche FQD12N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12N20LTF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD12N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20LTM-F085P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS DPAK 200V 280 MOHM</p>	 <p><b>FQD12N20 F</b> FQD12N20 F</p>
 <p><b>FQD12N20LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12N20LTM-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD1216ME/I H-5</b> NXP</p>	 <p><b>FQD12N20LTM FQD12N20 FAIRCHILD</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD12N20LTM FQD12N20 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20	↔ FQD10N20C	⇒ FQD10N20CTF	D FQD10N20CTF	⇒ FQD10N20CTM
⊕ FQD10N20CTM	⊗ FQD10N20D	D FQD10N20L	⇒ FQD10N20LTF	⇒ FQD10N20LTF
⊗ FQD10N20LTM	⊕ FQD10N20LTM	⊗ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TF	⇒ FQD10N20TM
D FQD10N20TM	⊗ FQD11P06	⊕ FQD11P06-NL	⊗ FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TF
⇒ FQD11P06TM	↔ FQD11P06TM	⊗ FQD12N10	⊕ FQD12N20	⇒ FQD12N20L
↔ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM	D FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⊕ FQD12N20TF
⊗ FQD12N20TM	D FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	↔ FQD12P10TF	⇒ FQD12P10TF
⊕ FQD12P10TM	⊗ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	⇒ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTM	⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF
↔ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TM	⊕ FQD13N06TM	⊗ FQD13N10	⇒ FQD13N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited